# 高出力超短パルスレーザー用 Yb:CaF2-LaF3 セラミックの研究

基盤理工学専攻 光工学プログラム 白川研究室 山角 謙太郎

### 1. はじめに

高出力超短パルスレーザーは、産業分野や高エネ ルギー分野において応用がなされており、さらなる 高出力化・超短パルス化が望まれている。

レーザーはその利得媒質の形状によりファイバ ーレーザーと固体レーザーに大別される。ファイバ ーレーザーは繊維状の利得媒質を用い、そのレーザ 一品質の高さや安定性の高さ、エネルギー変換効率 の高さや優れた熱特性をもち、現在主流なレーザー のひとつである。しかし、ファイバーレーザーはそ の形状上、光を伝搬させたときに非線形光学効果が 起きやすいことが知られている。この非線形光学効 果により出力の上限が制限されてしまうことから、 ファイバーレーザーはレーザー核融合等で求めら れる高強度パルス動作には不向きとされている。固 体レーザーはロッド上の利得媒質を用いており、利 得媒質の体積が無視できないことや熱による問題 の影響、そしてファイバーレーザーと比較して複雑 な光学系となるなどの欠点はあるが、高出力超短パ ルスレーザー発振器/増幅器として開発が盛んであ る。

固体レーザーの利得媒質は主に、レーザー発振に 直接寄与する希土類イオンとその添加先である母 材から構成されている。同じ希土類イオンであって も添加先の母材によって得られるレーザー特性は 大きく変化する。そのため、固体レーザーの利得媒 質のための新材料の研究・開発は非常に重要である。

Yb<sup>3+</sup>添加材料は高効率・高出力超短パルスレーザ ー用の利得媒質として現在積極的に研究されてい る。Yb<sup>3+</sup>イオンはエネルギー準位が2準位しか存在 せず、励起波長が940 nm~980 nm なので一般的な InGaAs 系の LD による高強度励起が可能である。 また、発振波長(~1030 nm)が励起波長と近いので励 起量子効率が高く、発熱も少ない。そのため、より 高効率・高出力化が期待でき、Yb<sup>3+</sup>添加材料は高出 力レーザーにおいて広く利用されている。

固体レーザーの利得媒質の母材としては主に単 結晶やガラスが用いられてきた。単結晶は母材とし ての特性は良好ではあるが、一般的な製法では試料 の大型化が困難かつ作製に膨大な時間がかかるな ど生産上の欠点がある。ガラスは比較的容易に大口 径試料が作製可能であるが、熱特性や機械特性が単 結晶に劣るという欠点がある。本研究の利得媒質で は単結晶とガラス双方の欠点を克服することがで きるセラミック材料を母材として用いている。

固体レーザー用のセラミック材料としては、1964 年に Dy<sup>2+</sup>:CaF<sub>2</sub>セラミックにおいて初めてのレーザ 一発振が報告された[3]。その後、単結晶と同等の性 能を得られないとされていたが、セラミック材料の 製造方法の開発が進み、近年では単結晶と同等かそ れ以上の性能を得られることが可能となり、現在セ ラミックレーザーは広く利用されている。

Yb:CaF2 は蛍光寿命の長さや利得帯域の広さから、超短パルスレーザー発振器や増幅器の利得媒質として注目されている材料である[2,3]。また、有望な特性をもつ Yb:CaF2 をセラミック化することによりさらなる応用に活かそうとする研究がなされている[4,5]。

本研究ではニコンとの共同研究により開発した Yb:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミック[6]について、基礎特性評価 およびレーザー発振実験、熱膨張係数と屈折率の温 度係数の測定を行った。

#### 2. Yb:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミック

本研究で使用した Yb:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub> セラミックは熱 間等方加圧法(Hot isostatic press, HIP 法)と呼ばれる 製法に基づいて作製されており[7]、母材であるフ ッ化カルシウム(CaF<sub>2</sub>)セラミックに希土類イオン であるイッテルビウム(Yb)とランタン(La)を添加 した材料である。

本研究では、La を共添加することによって 2 価の Yb イオン(Yb<sup>2+</sup>)の形成を抑制している。Yb<sup>2+</sup>は200 nm~400 nm に吸収をもち、非輻射損失や多光子吸収による熱負荷の原因となる。また、Yb<sup>2+</sup>が多く発生してしまうことは試料への実効的なYb イオン添加濃度を減少させ、レーザー発振効率の低下をもたらす。Yb<sup>2+</sup>は CaF<sub>2</sub>結晶内の電荷補償が十分でない場合に形成されやすい傾向がある。

Yb:CaF<sub>2</sub>のようなCa<sup>2+</sup>と価数が異なる3価の希土類 イオンを添加するような場合、添加濃度が増大する (> 0.05 at.%)と添加した希土類イオンが凝集しクラ スターが生成される。特に、1 at.%以上の濃度でイ オン半径の小さい希土類(Er<sup>3+</sup>や Tm<sup>3+</sup>、Yb<sup>3+</sup>など)を 添加した場合、Hexametric cluster と呼ばれる特殊な クラスターが生成され、結晶構造が変化することが わかっている(図 1)。このクラスターは複雑な結晶



場を有しているため、添加される希土類イオンのス ペクトルの広帯域化に寄与している[8]。しかし、一 方では量子効率の低下を招いていると考えられて いる。一般的に、蛍石型構造をもつ物質 MF<sub>2</sub>(M = Ca, Sr or Ba)と tysonite 構造をもつ物質 ReF<sub>3</sub>(Re = Y, La or Gd)では共晶系を形成することが知られてい る[9]。つまり、CaF<sub>2</sub>と LaF<sub>3</sub>や YF<sub>3</sub>のような希土類 フッ化物との化合物ではクラスターが形成されな い。実際に、La のようなイオン半径の大きい希土 類を添加した場合、Yb を添加したときのようなク ラスターは形成されにくいことがわかっている[2]。 本研究で使用した試料では、LaF<sub>3</sub>と CaF<sub>2</sub>が共晶系 を構成し、Yb<sup>3+</sup>が La<sup>3+</sup>サイトを置換することによっ て Yb<sup>2+</sup>の形成が抑えられていると考えている。

#### 3. 基礎特性評価

本研究で使用した Yb:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub> セラミック試料 を図 2 に示す。大きさはすべて厚さ 3.2 mm、直径 14 mm である。本研究では Yb:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub> セラミッ クの各種特性のイオン添加濃度依存性の調査を目 的としており、様々な Yb イオンと La イオンの添 加濃度(Yb, La イオン濃度 1 at.% ~ 6 at.%)のセラミ ック試料を用意した。



図2 Yb:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミック試料の写真

### 3.1 蛍光・吸収スペクトル

図3に測定した蛍光スペクトルを示す。スペクトル形状のイオン添加濃度による変化を見てみると、 Ybイオンの添加濃度上昇に伴い、スペクトル形状が広くなだらかに変化していた。このスペクトルの 変化の要因には、クラスター形成によるスペクトル の広帯域化が考えられる。一方で、Laイオン添加



図 3 Yb:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミックの蛍光スペクトル

濃度による変化は、Yb イオンの場合と比較して非 常に小さかった。

このイオン添加濃度によるスペクトル形状の変 化は吸収スペクトルでも同様の傾向が見られた。

### 3.2 蛍光寿命

表 1 に測定によって得られた蛍光寿命を示す。 Yb:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミックの蛍光寿命は 2.2 ms ~ 2.0 ms であり、イオン添加濃度が上昇すると蛍光寿命 が短くなる傾向が見られた。ただし、Yb:CaF<sub>2</sub>単結 晶の蛍光寿命 2.4 ms と比較した場合の蛍光寿命の 変化はわずかであった。

表1 Yb:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミックの蛍光寿命

蛍光寿命 / ms		Yb 添加濃度 / at.%		
		1	2	3
La 添加濃度 / at.%	1	2.2	2.2	2.1
	2	2.1	2.1	2.0
	3			2.0

Yb:CaF2単結晶 2.4 ms

# 3.3 UV-Vis-NIR 透過スペクトル

波長 185 nm~1300 nm の範囲で透過スペクトル測 定行った(図 4)。900 nm~1000 nm 付近に見える吸 収は Yb<sup>3+</sup>の吸収である。一方、400 nm 付近に見え る吸収は Yb<sup>2+</sup>の吸収である。添加濃度による透過 スペクトルの変化をみてみると、Yb イオン添加濃 度の比率が高い試料と比較して La イオン添加濃度 の比率が高い試料では Yb<sup>2+</sup>による吸収のピークが 抑えられていた。また、単結晶の場合と比較しても Yb<sup>2+</sup>による吸収のピークが抑えられていた。以上の 結果より、La の共添加により Yb<sup>2+</sup>の形成が抑制さ れていることが確認できた。





### 3.4 熱伝導率

測定した Yb:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミックと Yb:CaF<sub>2</sub>単 結晶の熱伝導率を図 5 に示す。Yb 添加濃度の上昇 に伴って熱伝導率が低下していた。これはクラス ター形成によるフォノン散乱が原因である。ただ し、単結晶と比較すると低添加濃度では熱伝導率 に大きな差があるが、3 at.%のときにはほぼ同程 度の値になっていた。



# 4. CW レーザー発振実験

Yb:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub> セラミックを利得媒質として共振 器を構成して CW レーザー発振実験を行い、その レーザー特性を評価した。実験配置図を図 6 に示 す。共振器はシンプルな I 型共振器構成となってお り、励起光源には IPG Photonics 社製、中心波長 975 nm、最大出力 30 W の VBG 波長安定化ファイバー



結合型レーザーダイオードを用いた。ファイバーの コア径は 105 µmであり、焦点距離 50 mm のレン ズ2枚を用いて試料に集光しており、集光径はお およそ 100 µmであった。試料は銅製のホルダーに 固定し、水冷されている。励起光は試料に垂直入射 されており、また、AR コーティングなどが施され ていないため、媒質の表面にて 5%程度のフレネル 反射が生じている。ただし、共振器構成がシンプル なためフレネル反射されたレーザー光のいくらか は共振器に再び結合するものと考えられ、フレネル 反射のすべて損失になるわけではないと考えられ る。出力結合鏡(OC)には曲率半径 50 mm、透過率 5%のものを使用した。試料に励起光を当て、出力 結合鏡透過後の光をダイクロックミラー(DM)で出 力光Poutと励起光の残留光Presに分け、それぞれを パワメーターで測定することで媒質に吸収された 光パワーPabsを算出し、吸収に対する出力の割合 (スロープ効率)を求めた。

図7にCWレーザー発振実験において得られた 入出力特性を、表2と表3に得られたスロープ効 率と最大出力をそれぞれまとめたものを示す。Yb イオン添加濃度が上昇するとより高い出力が得ら れ、さらに、同じYbイオン添加濃度の試料でもLa イオン添加濃度が上昇するとより高いスロープ効 率が得られた。これらは、Ybイオンの添加濃度が 上昇すると励起光吸収量が増大すること、Laイオ ン添加濃度が上昇するとYb<sup>2+</sup>の形成が抑制され実 効的なYbイオンの添加濃度が増大することが理由 だと考えられる。特に、3at.%La,2at.%Ybの試料 では最も高い最大出力4.35W、3at.%La,1at.%Yb の試料では最も高いスロープ効率 69.5%が得られ た。これまでに報告されているどのYb:CaF2セラミ ックの結果より優れた値を示した。

上記のような傾向から、Yb イオンの添加濃度が 高いかつ La イオン添加濃度の比率の高い試料が優 秀であると言える。しかし、Yb イオン、La イオン 添加濃度が高いほど 4.4.5 項で述べた熱伝導率の低 下の影響が著しく現れ、励起光強度を強くしていく と最大励起光強度に達する前に熱による試料破壊



表3 Yb:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミック試料の最大出力

最大出力パワー/W		Yb 添加濃度/ at.%		
		1	2	3
La 添加濃度/ at.%	1	1.80	1.92	3.40
	2	2.28	4.00	3.97
	3	1.59	4.35	2.01

#### 5. 屈折率の温度係数と熱膨張係数

### 5.1 レーザー媒質における dn/dT と $\alpha$

熱膨張係数αは温度上昇によって物体の長さや 体積が膨張する温度あたりの割合を示し、熱膨張率 とも呼ばれる。長さの変化を表す場合は線膨張係数 (線膨張率)、体積の変化を表す場合は体積膨張係数 (体積膨張率)であるが、一般的に熱膨張係数とは線 膨張係数のことを指す。屈折率の温度係数dn/dT は物質の温度変化による温度あたりの屈折率変化 の割合である。

熱伝導率、熱膨張係数、屈折率の温度係数はレー ザー媒質の熱特性の評価に特に用いられるパラメ ータであり、これらを測定することによって媒質の 熱レンズ効果や熱複屈折、熱応力のなど算出が可能 となる[10]。

レーザー媒質中で生じる熱による大きな問題として熱レンズ効果がある。熱レンズ効果は媒質中レ ーザーを照射した際に熱による屈折率分布が生じ、 媒質自体がレンズのような作用を発揮し光が収束、 または発散してしまう現象である。熱レンズ効果が 媒質中で強く生じてしまうと、レーザーのビーム品 質の劣化や媒出力限界の低下などの問題となる。熱 レンズ効果の大きさを表すパラメータとして thermal lens dioptric power *D*<sub>th</sub>があり、それは以下の ように書くことができる[11]

$$D_{th} = \frac{1}{f_{th}} = \frac{\eta_h P_{abs}}{2\pi w_p^2 \kappa} \left[ \left( \frac{dn}{dT} \right) + (n-1)(1+\nu)\alpha + 2n^3 \alpha C_r \right]$$
(1)

 $\eta_h$ は fractional thermal load(媒質に吸収された光のうち熱に変わる割合)、 $P_{abs}$ は媒質に吸収される光パワー、 $w_p$ はビームスポット径、 $\kappa$ は熱伝導率、nは屈折率、 $\nu$ はポアソン比、 $C_r$ は光弾性係数である。 $f_{th}$ は熱レンズ効果による焦点距離を表し、 $D_{th}$ が大きくなるほど $f_{th}$ の値が小さくなりビームが強く収束してしまうことを示している。

式(1)より、以下のような式から屈折率の温度係

の前兆(出力パワーの低下)が見られたり、実際に試料を破壊してしまった場合もあった。よって、無制限にイオン添加濃度を増やすことはでず、現状ではYb イオン、La イオン添加濃度の総量の上限が 5 at.%程度であると考えている。

スロープ効率/%		Yb 添加濃度/ at.%		
		1	2	3
La 添加濃度/ at.%	1	58.1	39.9	37.6
	2	67.6	52.9	47.5
	3	69.5	55.3	48.1

表2 Yb:CaF2-LaF3セラミック試料のスロープ効率

数dn/dTと熱膨張係数 $\alpha$ を用いて thermal lens dioptric power の簡単な見積もりができる。式(2)の 値が0に近づくほど $D_{th}$ が小さくなり、熱レンズ効 果が小さくなると言える。ただし、この見積もりは 光弾性効果による影響は考慮されていない。

$$D_{th} \propto \left(\frac{dn}{dT}\right) + (n-1)(1+\nu)\alpha$$
 (2)

### 5.2 負の屈折率の温度係数

一般的に利得媒質として用いられる材料では屈 折率の温度係数と熱膨張係数はどちらも正の値を 持つ。一方で、CaF2などの一部の材料では屈折率の 温度係数が負の値を持つことが知られている。表4 にいくつかの材料の屈折率の温度係数と熱膨張係 数の値をまとめたものを示す。負の屈折率の温度係 数を持つ材料では、式(2)より屈折率の温度係数に よる影響と熱膨張係数による影響が打ち消し合い、 熱レンズ効果が緩和することが期待される。本研究 で使用している Yb:CaF2-LaF3 セラミックも母材と して CaF2を用いているので負の屈折率の温度係数 の温度係数を持つと予想した。

表4 各材料の屈折率の温度係数と熱膨張係数(×10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup>)

	C I	Yb:CaF <sub>2</sub>	YAG
	Uar2 中和田	単結晶	セラミック
dn/dT	-12.7	-10.35	10.7
α	18.8	19.3	7.8
参考	[12]	[12]	[13]

### 5.3 屈折率の温度係数の測定

屈折率の温度係数測定には干渉計を用いる方法 が知られており、本研究では Fizeau 干渉計を用い た測定を行った。図8にその実験配置図を示す。参 照光には He-Ne レーザー(波長 632.8 nm)を用い、試 料の表面と裏面の反射光による干渉縞の温度変化 を観測した。このとき、試料の温度をΔTだけ変化 させたときに干渉縞の明暗が1周したとすると以 下の式からdn/dTを算出することができる。

$$\frac{dn}{dT} = \frac{\lambda}{2L\Delta T} - n\alpha \tag{3}$$

λは参照光の波長、Lは試料の長さ、nは屈折率、α は熱膨張係数である。



図8 Fizeau 干渉計による屈折率の温度係数の測定

測定によって得られた干渉縞の明暗の変化を図 9 に示す。干渉縞の明暗の変化は光検出器によって 測定し、試料の温度は K 型熱電対を用いて測定を 行った。試料の加熱にはマイクロセラミックヒータ 一MS-2(坂口電熱株式会社)を用い、試料の長さは 5.7 mm であった。また、熱膨張係数の値について はニコン株式会社に依頼して押し棒式膨張計法に よる測定を行い、屈折率の温度係数の算出に用いた。

測定によって得られた∆Tの値は 3.78℃であった。 したがって式(3)より、試料の屈折率の温度係数は 以下のように算出できた。

$$\frac{dn}{dT} = \frac{\lambda}{2L\Delta T} - n\alpha = -8.62 \times 10^{-6} \,\mathrm{K}^{-1} \qquad (3)$$

参照光の波長 $\lambda$ は 632.8 nm、屈折率nは 1.43、熱膨 張係数 $\alpha$ は16.3 × 10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup>を用いた。



本研究で使用した Yb:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub> セラミックは表 4 で示した CaF<sub>2</sub>単結晶や Yb:CaF<sub>2</sub>単結晶と同じよ うに負の屈折率の温度係数を持つことが確認でき た。また、CaF<sub>2</sub>単結晶や Yb:CaF<sub>2</sub>単結晶より屈折率 の温度係数の値が大きくなっているが、これは La を添加している影響だと考えられる。

表 5 に今回測定した Yb:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub> セラミック (3La2Yb)と他の材料について式(2)による熱レンズ 効果の見積もりを示す。表 5 から、Yb:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セ ラミックの熱レンズ効果の見積もりの値は他の材 料に比べて小さいことが分かる。また、Yb:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミックでは Yb と La の添加量を調整する ことによって、熱レンズ効果の更なる軽減が期待で きると考えている。

表5 熱レンズ効果の見積もり(×10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup>)

	CoF- 尚結見	YAG	Yb:CaF <sub>2</sub> -LaF <sub>3</sub>
	Car2 半和田	セラミック	セラミック
dn/dT	-12.7	10.7	-8.62
α	18.8	7.8	16.3
熱レンズ効果	_2.01	187	_0.13
の見積もり	-2.91	10.7	-0.15
参考	[12]	[13]	本研究

ポアソン比:CaF2 単結晶 0.21, YAG セラミック 0.23 屈折率:CaF2 単結晶 1.43, YAG セラミック 1.83

## 6. まとめ

超短パルスレーザー用の利得媒質として期待さ れる Yb 添加 CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミックについて、様々 な Yb イオン・La イオン添加濃度の試料を作製し、 基礎特性評価と CW レーザー発振実験、屈折率の 温度係数測定を行った。基礎特性評価ではYb:CaF2-LaF3セラミックの Yb, La イオン添加濃度依存性を 調べ、UV-Vis-NIR 透過スペクトル測定に置いて、 La イオンの共添加によって Yb<sup>2+</sup>の形成が抑制され ていることを確認した。CW レーザー発振実験では それぞれの添加濃度を変えることによって、高出力 や高効率を得ることができたが、合計の添加濃度は 試料の熱特性の低下により制限されてしまう問題 も確認された。屈折率の温度係数測定では、3L2Y の試料において-8.62×10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup>という負の値を持つ ことが確認できた。今後の展望としては、屈折率の 温度係数の測定が 3L2Y の試料に対してしか行っ てないため、その他の組成の試料に対しても屈折率 の温度係数測定を行うことや、今回ニコンに依頼し 押し棒式膨張計法による測定を行った熱膨張係数 に関しても表面に金コーティングなどを施すこと

によってフィゾー干渉計を用いた測定を行うことで、Yb:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミックの熱レンズフリーの可能性の探求を行う。

### 参考文献

- [1] S. E.Hatch *et.al.*, Appl. Phys. Lett. 5, 153 (1964).
- [2] M. Siebold et. al., Appl. Phys. B 97, 327 (2009).
- [3] F. Druon *et. al.*, Opt. Mater. Express **1**, 489 (2011).
- [4] M. E. Doroshenko *et. al.*, ASSL, Technical Digest, 2013, paper AM1A.6.
- [5] P. Aballea *et/al.*, Optica **2**, 288 (2015)
- [6] A. Shirakawa *et. al.*, ASSL, Paris, France, 27 October-1 November, 2013. JTh5A.7
- [7] H. Ishizawa, U.S. patent 20,140,239,228 (August 28, 2014).
- [8] V. Petit *et. al.*, Physical Review B **78**. 085131 (2008)
  [9] M. Švantner *et. al.*, Cryst. Res. Technol. **14**, 365 (1979).
- [10] W. Koechner, (2006). *Solid-State Laser Engineering*. Springer.

[11] S. Chénais *et. al.*, IEEE Journal of Quantum Electronics **40**, 1217 (2004).

[12] V. Cardinali et. al., Optics Materials 34, 990 (2012).

[13] H. Furuse *et. al.*, Optics Mater. Express **4**, 1794 (2014).